

Title	簡単な分子結晶のPremelting
Author(s)	阿竹, 徹
Citation	大阪大学低温センターだより. 1976, 13, p. 8-12
Version Type	VoR
URL	https://hdl.handle.net/11094/4036
rights	
Note	

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

Osaka University

簡単な分子結晶のPremelting

理学部 阿 竹 徹 (豊中 2500)

1) 簡単な分子結晶のカロリメトリー

この種の実験的研究は、大きくわけてHe, H₂, CH₄など低温で直接量子効果があらわれるものとN₂, CO, C(CH₃)₄等々のいわば古典結晶ともいべきものに分類できる。いずれも結晶内の分子運動の研究を行なう際、理論的取扱いの対象となりやすいものであるが、後者についての研究は意外に地味な分野に属し、例えばN₂など熱容量のデータは1933年のものしかない。転移やlattice dynamicsについての研究が発達したので、精密な測定が必要になってきているのが現状である。

実験技術の上からは、室温で気体状態にあるものと液体状態であるものとは大きな違いがあり、前者については凝縮気体用熱量計¹⁾(本センターだより第9号)を用いる必要がある。我々は特に熱力学第3法則に関して、この種の研究を行なってきており、最近CO結晶について液体水素温度でCO ↔ OCの秩序無秩序に対応すると思われる緩和現象の熱異常を見出した²⁾。これについては液体水素が豊富に手に入り次第、更に詳しい実験を行う予定であり、従来ミステリーとされてきた、 $R \ln 2$ よりもかなり小さい(約 $\frac{2}{3}$)残余エントロピーの問題が解明できるものと期待している。これについては別の機会にゆずり、ここではもう一つの問題として熱力学上の一次転移の低温側にみられる熱異常(熱容量のまくれ上がり)について紹介する。

2) 簡単な分子結晶のPremelting

この種の研究の例としては、千原³⁾のAr, Krに関するものがある。きわめて純粋な試料の熱容量が融点の下で異常にまくれ上がり、あらゆる他の効果を差し引いても、格子欠陥の発生による寄与を考えば説明できないという結論が得られている。

ところでこのような熱容量のまくれ上がりは、実は他の分子結晶についてもふつうにみられるものである。ただ試料の純度や測定精度の問題もあった為に、単にpremelting (pretransition)として片づけられてきたものと思われる。非常に純度の高い試料について精密な測定を行った場合には、物質本来の性質として興味深いものがある。

我々が99.99%以上の純度のN₂O¹⁾について得た結果を図1, 2に示す。defectの生成エンタルピーとして、 $10.8 \pm 0.6 \text{ kJ mol}^{-1}$ が得られたが、これは同時に得られた0 Kにおける昇華熱H₀の45%に当たっている。また結晶中で分子を180°回転させるときのbarrierを簡単な計算から見積ると約 3.4 kJ mol^{-1} となり、defectの生成エンタルピーはこの約 $\frac{1}{3}$ に当る。これらはdefectのできやすさをあらわしていると考えられるので、先のAr, Krの場合と比較すると表1のようになり、今の場合はlattice defectよりもむしろorientational defectができていたと考えた方がよさそうである。一つの根拠として、結晶構造の等しいN₂, CO, CO₂との比較を試みる。N₂とCOは回転転移があり、高温相では6方対称となり、spherical rotationではないすこぎ運動的回転

をしている。この場合は、転移点より低温側での熱容量のまくれ上がりは orientational defect に、また融点の下のは lattice defect によると考えられる。融点下については測定精度が悪く解析できないが、転移点下については表1のような値が得られる。N₂O には転移がないが、この比較から融点の直上に N₂, CO と同様な回転転移を有するものと推定できる。高圧下では転移が融点よりも低温側にあらわれる可能性がある。

他の例として M(CH₃)₄ (M=C, Si, Ge, Sn) を考えてみる。このうち C(CH₃)₄ だけが転移を有する。Si(CH₃)₄ については、最近我々は第3の準安定結晶相を見出し、従来のいろいろな実験データにおける混乱を解明した。⁴⁾ この安定結晶相の融点下については、図3のような結果が得られた。この場合、2つの勾配は orientational defect と lattice defect に対応しているのであろうか。どうもそうではなさそうである。この場合はこの2種類の defect の生成エンタルピーはあまり違わないと想像でき、それが勾配のゆるい方に当たっていると考えられる。急勾配の方は、結晶の凝集エネルギーよりも大きい値を与えるから、何らかの defect の生成によるとは考えられない。むしろこれは融解現象そのものをひっかけていると考えた方がよさそうである。Sn(CH₃)₄ についても同様な現象が見られる。⁵⁾ 一次転移である融解現象は温度領域がせまく、わずかな温度幅はふつう不純物によると考えられてきたが、純度の高い試料についてもこのようにかなり広い温度幅で融解現象がとらえられることは興味深いことである。

かなり低い温度領域から、熱的な励起によって種々な defect が発生していると考えられるが、この前駆現象を確かにとらえるためにはカロリメトリーだけでは決定的に不足である。しかしこのような励起は、ちよっと見積ってみても融点直下でも全分子数の1%にもみたく、他の測定手段ではとらえにくいものである。最近 optical Kerr effect を用いた研究が行われた。⁶⁾ 図4はその succinonitrile についての結果であり、パラメーターζが融点に至るまでに次第に減少してゆくのがとらえられている。また融解現象そのものをマイクロな立場でとらえようとする試みもある。⁷⁾ このように一次転移についての実験的研究が発展してゆけば、やがて理論との直接的な結合が可能となるだろう。

- 1) T. Atake and H. Chihara, Bull. Chem. Soc. Japan, **47**, 2126(1974).
- 2) to be published.
- 3) R.H. Beaumont, H. Chihara and J.A. Morrison, Proc. Phys. Soc., **78**, 1462(1961).
- 4) T. Atake, M. Harada and H. Chihara (to be published).
- 5) T. Atake and H. Chihara (to be published).
- 6) T. Bischofberger and E. Courtens, Phys. Rev. Lett., **32**, 163(1974).
- 7) T. Shinoda, 分子構造総合討論会, 4G05(1975).

	Ar	Kr	N ₂	CO	N ₂ O	CO ₂
$\Delta H_d / \text{kJ mol}^{-1}$	5.36	7.41	2.00	3.00	10.80	20.00
$H_0^\circ / \text{kJ mol}^{-1}$	7.72	11.15	6.90	8.00	24.20	27.00
$\Delta H_d / H_0^\circ$	0.69	0.66	0.29	0.38	0.45	0.74

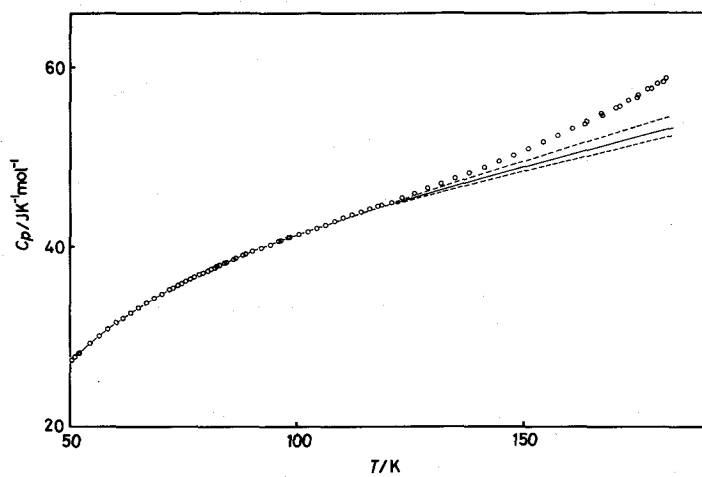


図1. N₂Oの比熱

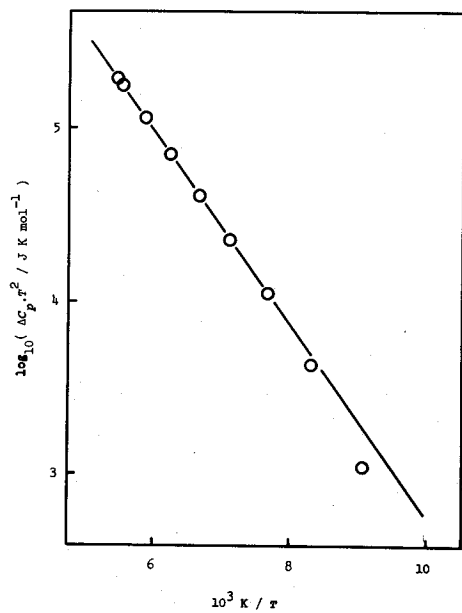
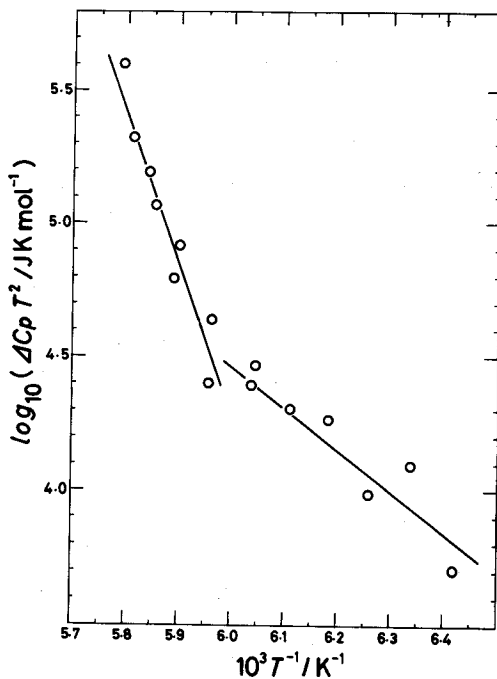
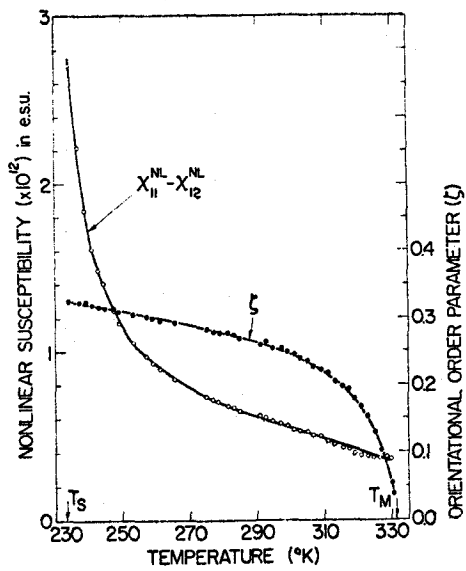


FIG. 2. PLOT OF $\log_{10}(\Delta C_p T^2)$ AGAINST $1/T$ FOR DINITROGEN OXIDE.

⊠ 2. N_2O



⊠ 3. $Si(CH_3)_4$



The measured susceptibility and anisotropy.

⊗ 4. Succinonitrile